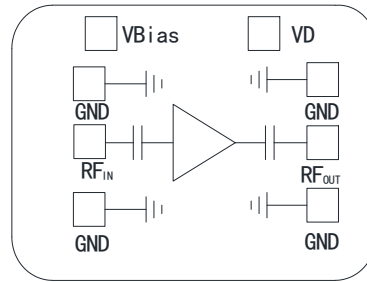


特点:

- 频率范围: 10.0~26.0GHz
- 增益: 20.5dB@+3V; 21dB@+5V
- 噪声系数: 1.2dB@+3V; 1.7dB@+5V
- 输出-1dB 压缩点: 8.5dBm@+3V; 11.0dBm@+5V
- 输出 IP₃: 8.5dBm@+3V ; 11dBm@+5V
- 单电源工作: +3V@20mA; +5V@42mA
- 芯片尺寸: 1.14mm×1.0mm×0.1mm

功能框图:



产品简介:

YDC1110 是一款采用 GaAs pHEMT 工艺设计制造的低噪声放大器芯片。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

性能参数 1: (50Ω系统, T_A=+25℃, V_{dd}=+3V, I_{dd}=20mA, Vbias 悬空, 探针测试)

参数名称	符号	参数值			单位
		MIN	TYP	MAX	
频率范围	Frequency	10.0	-	26.0	GHz
增益	Gain	-	20.5	-	dB
增益平坦度	ΔG	-	±1.5	-	dB
输入驻波比	VSWR _I	-	1.4	-	-
输出驻波比	VSWR _O	-	1.4	-	-
噪声系数	NF	-	1.2	-	dB
反向隔离度	IR	-	36	-	dB
输出 P-1dB	OP-1dB	-	8.5	-	dBm
输出 IP ₃ *	OIP ₃	-	20	-	dBm
电源电压	V _{dd}	-	+3	-	V
工作电流	I _{dd}	-	20	-	mA

*: OIP₃ 测试条件: 双音信号间隔 1MHz, P_{out}=+0dBm/tone。

**：芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

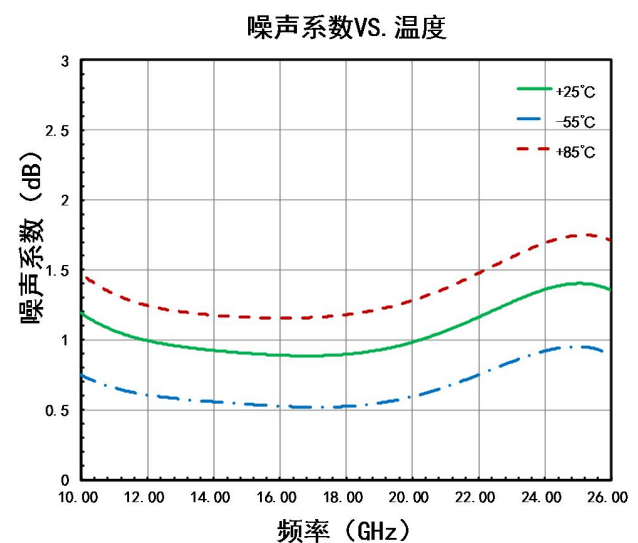
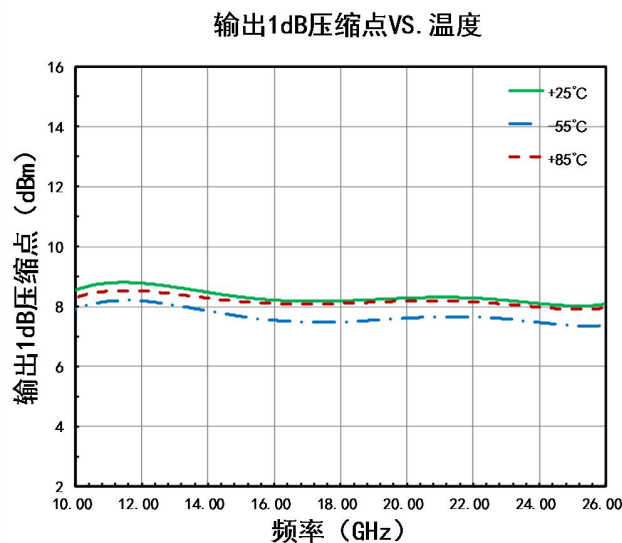
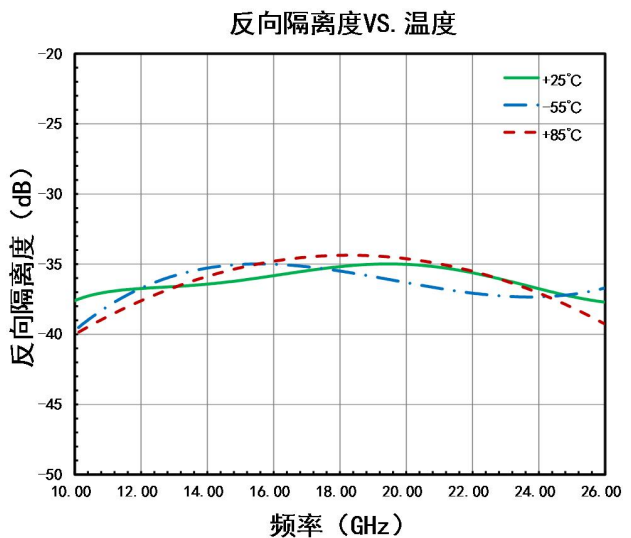
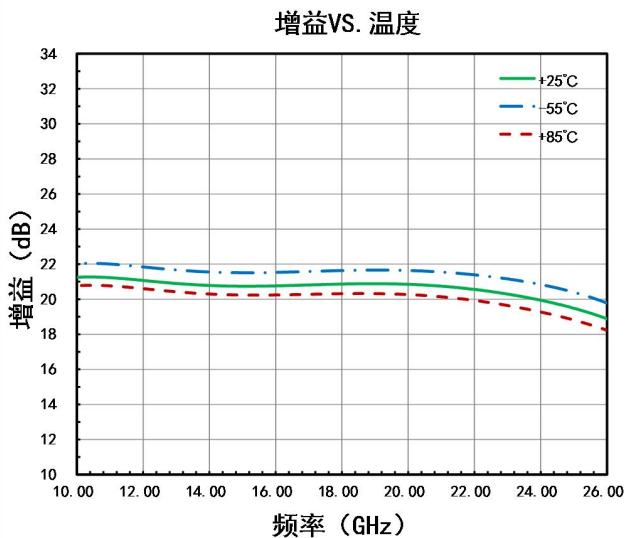
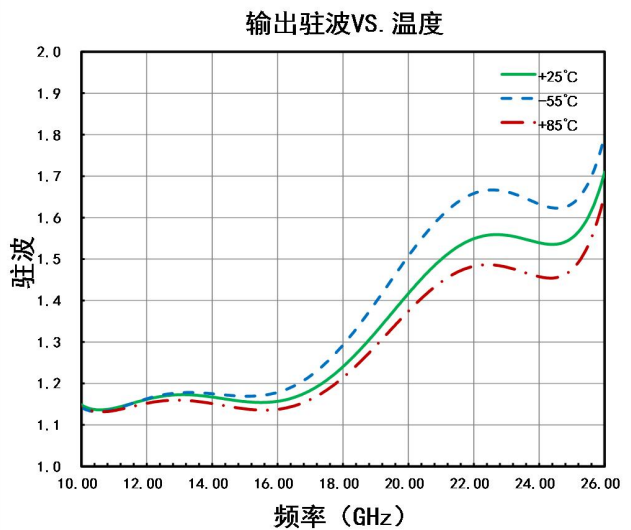
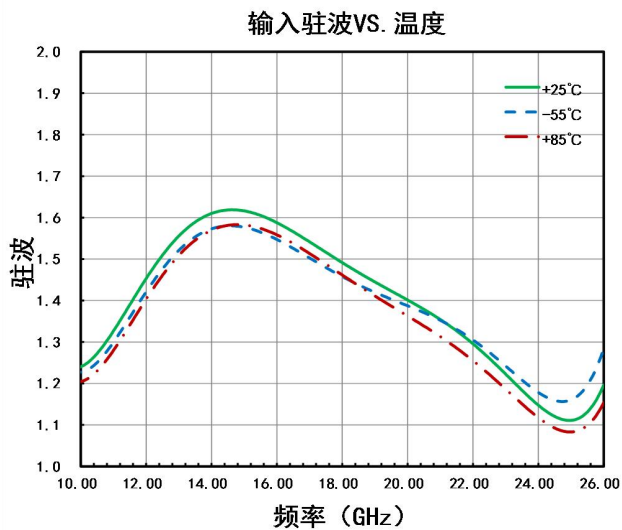
性能参数 2: (50Ω系统, T_A=+25℃, V_{dd}=+5V, I_{dd}=42mA, Vbias 悬空, 探针测试)

参数名称	符号	参数值			单位
		MIN	TYP	MAX	
频率范围	Frequency	10.0	-	26.0	GHz
增益	Gain	-	21	-	dB
增益平坦度	ΔG	-	±1	-	dB
输入驻波比	VSWR _I	-	1.3	-	-
输出驻波比	VSWR _O	-	1.3	-	-
噪声系数	NF	-	1.7	-	dB
反向隔离度	IR	-	37	-	dB
输出 P-1dB	OP-1dB	-	11	-	dBm
输出 IP ₃ *	OIP ₃	-	20	-	dBm
电源电压	V _{dd}	-	+5	-	V
工作电流	I _{dd}	-	42	-	mA

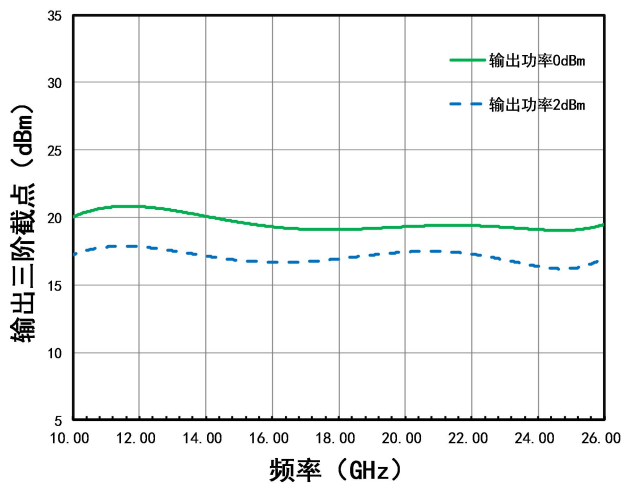
*: OIP₃ 测试条件: 双音信号间隔 1MHz, P_{out}=+0dBm/tone。

**：芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

典型测试曲线 1: (50Ω系统, $V_{dd}=+3V$, $I_{dd}=20mA$, V_{bias} 悬空, 探针测试)

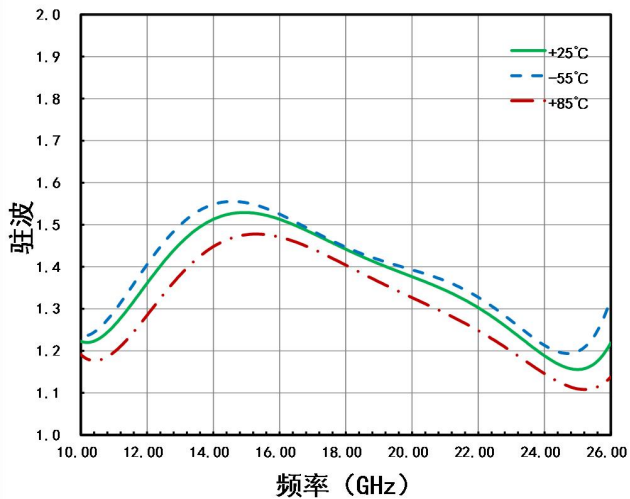


输出三阶截点VS. 频率(+25°C)

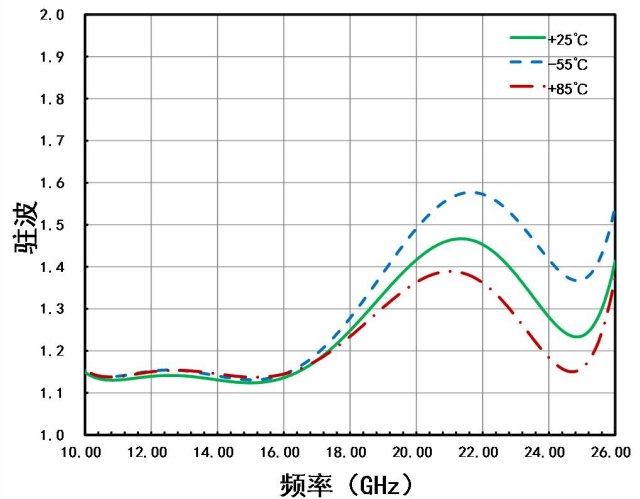


典型测试曲线 2: (50Ω系统, $V_{dd}=+5V$, $I_{dd}=42mA$, V_{bias} 悬空, 探针测试)

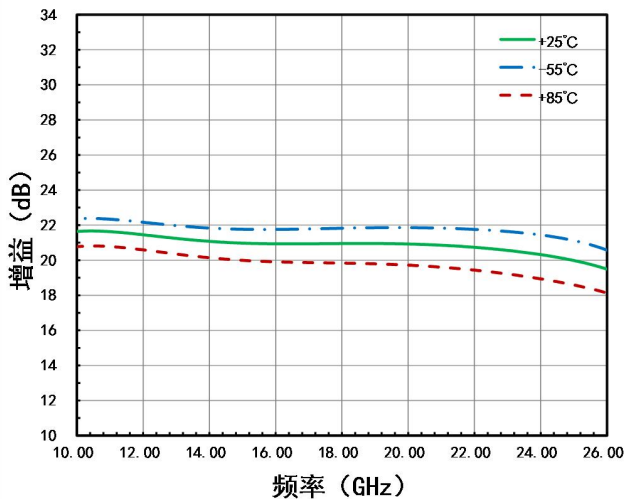
输入驻波VS. 温度



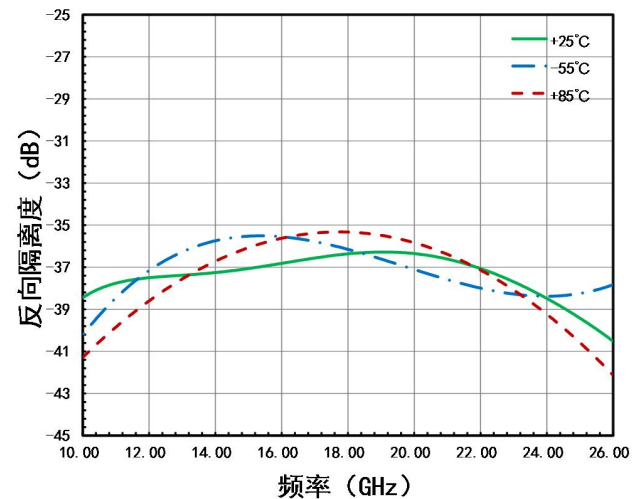
输出驻波VS. 温度



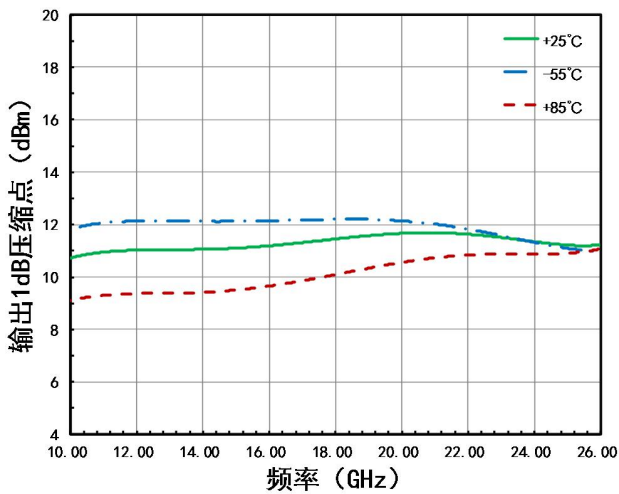
增益VS. 温度



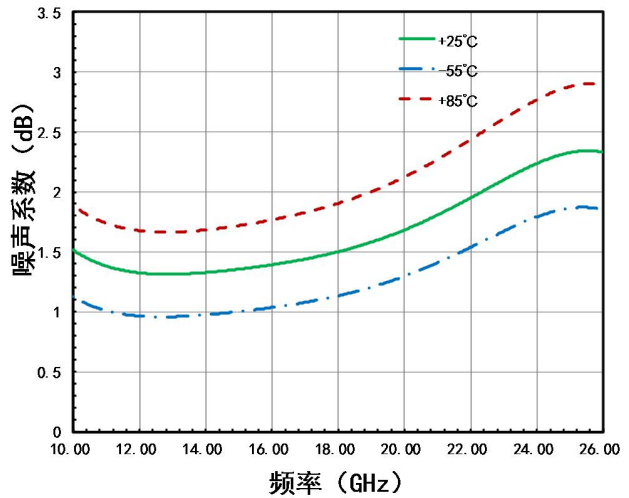
反向隔离度VS. 温度



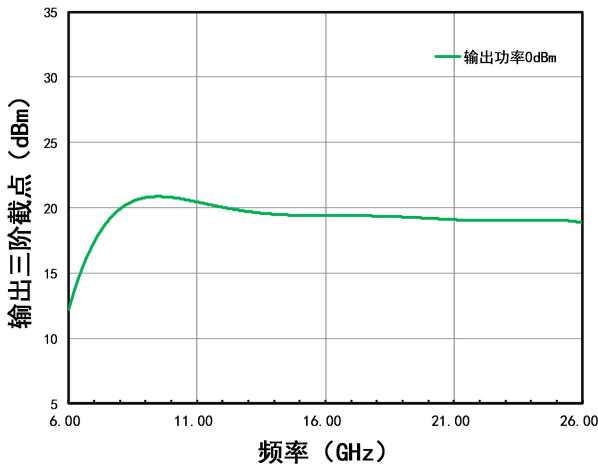
输出1dB压缩点VS. 温度



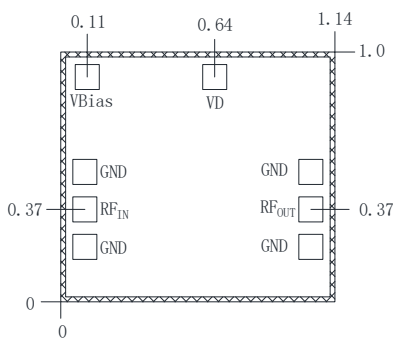
噪声系数VS. 温度



输出三阶截点VS. 频率(+25°C)



外形尺寸图:



注: 1.单位: mm;

2.芯片背面镀金, 背面接地;

3.外形尺寸公差: $\pm 0.05\text{mm}$;

4.键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1 \times 0.1\text{mm}$ 。



引脚定义:

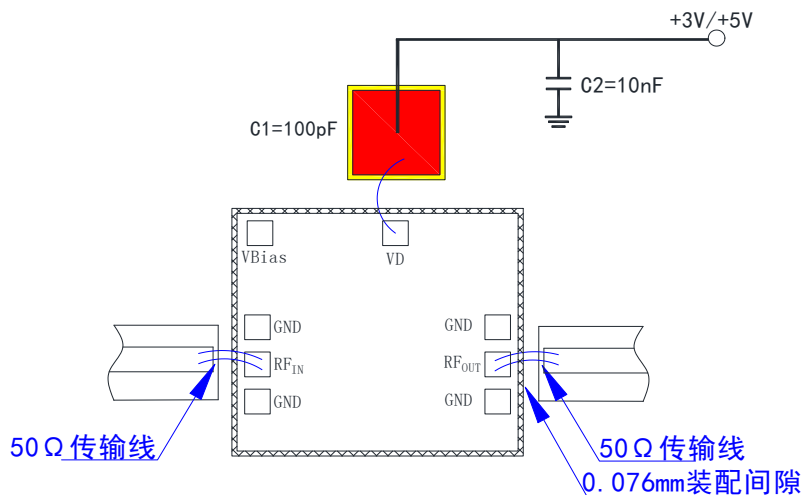
符号	描述
RF _{IN}	射频输入, 内部有隔直
RF _{OUT}	射频输出, 内部有隔直
VD	电源端口, +3V/+5V 供电
VBias	电流控制端口, 常规使用下悬空
GND/芯片背面	接地, 芯片底部需接地良好

极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率, 50 Ω	+20dBm
电源电压	+6V
装配温度	+300°C, 20s
工作温度	-55°C~+85°C
贮存温度	-55°C~+150°C
静电放电敏感度等级	1A

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。

推荐装配图：



注：射频端口应尽量靠近微带线以缩短键合金丝尺寸，典型的装配间隙是 0.076~0.152mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度尽量短，金丝尽量靠近芯片。

产品使用注意事项：

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用。
2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面，使用时须小心。
3. 芯片粘结装配时，需考虑热膨胀应力对芯片的影响，芯片建议烧结或粘结在热膨胀系数相近的载体上，如可伐、钨铜或钼铜垫片上，避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
4. 芯片使用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过+300°C，时间不能超过 20 秒），使之充分接地。
5. 芯片射频端口使用 25 μm 双金丝键合，建议金丝长度 0.25~0.40mm（10~16 mils）。
6. 在存储和使用过程中注意防静电，烧结、键合台接地良好。